

## 結晶成長のステラ問題の級数解

宇都宮大・教養 徳田 尚之

### § 1. はじめに

集積回路に欠かすことの出まわりのシリコン結晶<sup>1)</sup>, LPE法によるガーネット磁気バブル薄膜<sup>2)</sup>, GaAs太陽電池, III-IV化合物レーザ結晶<sup>3)</sup>等実用上重要な半導体の製造工程は, 液相から固相を析出し, その結晶成長中界面は動く自由境界面と存するいわゆる“ステラ問題”と存する。ステラ問題は元素半導体, プラズマ, 鋳造冷却等熱伝導を対象とし, 問題が数多く研究されて来たが, 結晶成長に伴うステラ問題では, 不純物を含んだり(シリコン結晶), 多元素(ガーネットバブル, GaAs等)である場合が多くその様な場合には物質伝導を行う。この結晶成長問題で殊に重要なのは境界条件であり, 特に界面条件の取扱いについては結晶成長の律速過程と複雑な関係してくるので細心の注意が必要である。

本論文では等温状態における二元系の結晶成長ステラ問題と取扱う。二元系結晶成長の界面条件を§2でまず議論する。§3では, 本研究の骨格となる Lagrange-Bürmann 展

周 (今後 L-B 展開等と略す) の概要を述べる。§4 の問題を定式化する。§5 では、変数変換を導入することにより、かゝる §3 で紹介する L-B 展開法がこの非線形境界値問題の解法に導入し得ることを示す。§6 では、まず濃度場の解を求め、§7 では、複雑な界面条件が帰着する L-B 展開を決定する。§8 では、その逆変換をとることにより、この問題が最も重要な関数 (月の関数とよぶ) 界面位置  $\lambda(t)$ 、界面濃度  $u_w(t)$  を求める。

## §2. 二元系の律速過程と界面条件

二元系結晶成長の律速過程は大変複雑である。ことに界面律速がある場合には、実験を説明しうる理論は一元系の場合に限られるといわれ、こまらるう。この理論は二次元核の形成を基礎とし、かかる論的 KOSSEL モデルと土台にし、準完全結晶のらせん転位を取り込んだ BCF 理論<sup>4)</sup> で完成されたといわれ、こまらるう。二元系結晶への拡張には、異種分子間の相互作用の影響もかかる界面の区分子新<sup>3)</sup> なる要素が加わる。一般的には、適当な仮想的結晶成長単位を想定して一元系結晶<sup>1)</sup> の BCF 理論<sup>2)</sup> を用<sup>流</sup>する場合が多い。

一方、成長速度が充分遅い場合、律速過程は界面律速ではなく環境相の拡散律速である場合が多い。この様な二元系結晶

融液システムでは、環境相と結晶相とが熱力学的平衡状態にあり、いわゆる相平衡図を満足している。図1に二元A, Bからなる典型的な相平衡図を示す。濃度 $u_0^*$ の融液を温度 $T_e^*$ に

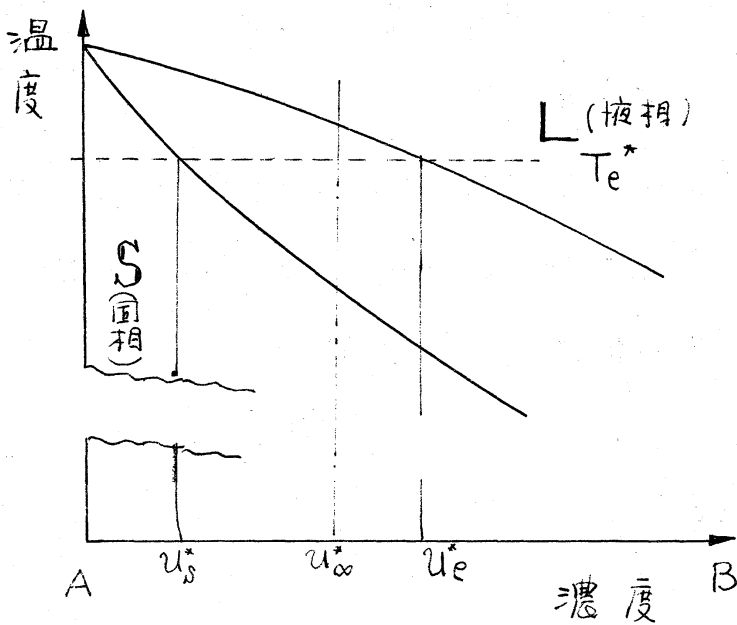


図1 典型的な相平衡図

保つと、固体側の界面濃度は $u_s^*$ 、液体側は $u_0^*$ となる。界面律速と拡散律速の両方を組み入れた連続体枠内での界面条件が最近Ghez<sup>5), 6)</sup>により提唱されている。

る。

Ghez<sup>5)</sup>はまず上に述べた意味での二元系BCFモデルに沿って界面での物質の流束密度と計算し<sup>6)</sup>た上で次のモデル方程式を提唱した。

$$D \frac{\partial u^*}{\partial x} = h (u_w^* - u_e^*) \quad \text{at } x=0 \quad (2.1)$$

ここで $x$ 座標の原点は界面上に取、 $h$ は定数である。

式(2.1)は、界面濃度 $u_w^*$ の熱力学的平衡界面濃度 $u_e^*$ からのずれの量と濃度勾配による物質の流束密度は比例すること

を示す。この連続体近似の界面条件は、熱条件としてよく使われる Newton の公式も全く軌を一にするものであり、数学的には Taylor 展開の初項を使、<sup>6)</sup> 近似と考ると便利がある。式(2.1)の判点<sup>6)</sup>は界面律速の状態では BCF 理論を満足し、この<sup>6)</sup>のみならず、坳り密度のホエ<sup>6)</sup>(成長速度の遅い)極限  $\frac{U}{c} \rightarrow 0$  では、界面条件は熱力学的平衡状態  $u_w^* \rightarrow u_e^*$  とも構えすることがある。界面条件(2.1)を用いると等温状態での結晶成長を考えても界面濃度  $u_w^*$  は一定値でありえず、実際相平衡図の  $u_w^* \sim u_e^*$  の間と変化する。これは熱のステーション問題には見られず、<sup>6)</sup> 現象とい、こよりある。

### §3. L-B 展開法の概要

文献<sup>7)</sup>に詳しく述べられているのでこいではそのあうましと述べるにとどめる。z を複素変数として解析関数  $f(z)$  と評価するの<sup>7)</sup>に Taylor 展開は基本的である。

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n + \dots \quad |z| < z_0 \quad (3.1)$$

$f(z)$  とその収束域内で出来るだけ正確に求めるには、(3.1)式の級数の係数を多く求める努力をする訳だが、多くの場合(3.1)の級数の収束は非常に遅く実用的には全く役に立たない場合が多いのは我々のよく経験するところである。これを次のように解析関数を使、<sup>7)</sup> 変数変換により、より収束性のよ

の  $L-B$  級数を導入しようとするのがこの  $L-B$  展開法の骨子である。

### 定理 1 (L-B 定理)

$z=0$  で正則な関数  $h(z)$ ,  $g(z)$  による変数変換を考へる。

$$\tau = H(z; f; f') = h(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n, \quad (3.2)$$

$$j = G(z; f) = g(z) = \sum_{n=c}^{\infty} c_n z^n. \quad (3.3)$$

すると  $z=0$  で (3.2) の逆関数  $h^{-1}(z)$  が正則であり, (3.3) の  $g(z)$

との合成関数  $p(z) = g \circ h^{-1}$  が  $z=0$  で正則である。可成り

$$z = h^{-1}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n z^n \quad (3.4)$$

$$j = g(h^{-1}) = p(z) = \sum_{n=c}^{\infty} A_n z^n \quad (3.5)$$

$z$  で  $f' = \frac{df}{dz}$  であり,  $H, G$  はそれぞれ  $z, f, f'$  と  $z, f$  に依り,  $z$

定義され,  $h, g$  は解析関数  $h, g$  を定義する。ことに  $h, h^{-1}$  は

定数項が有りことに注意されたい。式 (3.5) は  $L-B$  展開と

本技法の中核をなす。

我々の目標はあくまで  $f(z)$  (目的関数とよぶ) の評価である。

(3.5) 式から次の手順で  $f(z)$  を求める。

### 定理 2 (逆変換の定理)

(3.5) 式の逆関数  $P^{-1}$  が  $j-A_0=0$  で正則である。

$$\tau = P^{-1}(j-A_0) \quad (3.6)$$

式 (3.2), (3.3) の定義式を使うと, (3.6) 式は

$$H(z; f; f') = P^{-1}[G(z; f) - c_0]. \quad (3.7)$$

となる。式(3.7)は簡単な変形を $f(z)$ に対する一階の常微分方程式となり、その解は(3.2)~(3.6)が定義されている範囲で同関数 $f(z)$ を与える。

### 定理3 (収束の定理)

L-3層周(3.5)式を $z$ の多項式、 $n$ 級数 $P_n$ と考える。

$$P_n(z) = \sum_{i=0}^n A_i z^i \quad (3.8)$$

(3.8)式の逆関数 $P_n^{-1}$ で定義される一階の微分方程式は

$$H(z; f^{(n)}, f^{(n)}) = P_n^{-1} [G(z; f^{(n)}) - C_0] \quad (3.9)$$

となる。(3.9)式の解 $f^{(n)}(z)$ は $n \rightarrow \infty$ で同関数 $f(z)$ に一致収束する。

証明等は文献<sup>(7)</sup>を参照されたい。

### §4. 基礎方程式

二元系結晶成長を考えよう。濃度 $u_0$ の融液システム(図1をみよ)を時間 $t \geq 0$ では常時温度 $T_c$ に保つ等温状態と考える。この状態では、濃度 $u_0$ の固体が $t=0$ で結晶しはじめ、時間 $t$ では厚さ $X(t)$ の結晶に成長する。結晶中の物質拡散は無視出来るので、この結晶成長問題は融液中の濃度分布と界面条件により支配されると考えよう。もし座標原点を動く界面上に固定すれば、この結晶成長システムの問題を支配する方程式と境界条件は次のようになる。

$$\frac{\partial u^*}{\partial t^*} = D \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + m \dot{X}^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \quad (4.1)$$

$$u^*(x^*, t^*) = u_s^* \quad x^* < 0 \quad (4.2)$$

$$D \frac{\partial u^*}{\partial x^*}(0, t) = \dot{X}^* (u_s^* - u_w^*) \quad (4.3)$$

$$u^*(x^*, 0) = u^*(\infty, t^*) = u_\infty \quad (4.4)$$

$$D \frac{\partial u^*}{\partial x^*}(0, t) = h (u_w^* - u_e^*) \quad (4.5)$$

$$X^*(0) = 0 \quad (4.6)$$

2.  $m$  は単位長さの結晶を作りだすのに必要な融液層厚さの比<sub>(無次元量)</sub>を表わす。この  $m$  のが (4.1) 式の右辺第二項は移動座標系のために生じる対流項である。  $D$  は物質拡散係数である。

(4.5) 式は §2 で論じた Ghez<sup>5), 6)</sup> による一次反応モデル<sup>5)</sup> は一次反応係数<sup>6)</sup>を示す。(4.3) は界面での物質保存則である。

次の無次元化により (4.1) ~ (4.6) を無次元変数に書き直す。

$$x = \frac{h}{D} x^*, \quad X = m \frac{h}{D} X^*, \quad t = \frac{h^2}{D} t^*, \quad u = \frac{u^* - u_\infty^*}{u_w^* - u_\infty^*}, \quad u_e = \frac{u_e^* - u_\infty^*}{u_s^* - u_\infty^*}, \quad u_w = \frac{u_w^* - u_\infty^*}{u_s^* - u_\infty^*} \quad (4.7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{u_w}{u_w} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + X \frac{\partial u}{\partial x} \quad (4.8)$$

$$u(x, t) = \frac{1}{u_w} \quad x < 0 \quad (4.9)$$

$$u(0, t) = 1, \quad u(\infty, t) = u(x, 0) = 0 \quad (4.10)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = X \left( \frac{1}{u_w} - 1 \right) \quad (4.11)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(0, t) - \frac{u_e}{u_w} \quad (4.12)$$

$$X(0) = 0 \quad (4.13)$$

無次元方程式 (4.8) ~ (4.13) をおこなうことができることは、この問題

の唯一のパラメータは  $u_0$  で、平衡状態での界面濃度と結晶相濃度の比を表わす。 $u_0$  と  $\lambda$  はとくに時間の尺度で濃度変数  $u(\lambda, t)$  と同時に求めなければならぬ量である。(4.8) をみてすぐ分かるように、濃度拡散方程式は境界条件によつて決まる  $\lambda$  と  $u_0$  に依存している。結晶相内の変化は考慮しないので境界条件(4.9)は今後考慮しない。 次に L-B 展開法を使つて、其解法を示そう。

### §5. 式の変数変換と L-B 展開の導入

独立変数  $x, t$  の代わりに次の独立変数  $\eta, \tau$  を導入しよう。

$$\eta = \frac{x}{2\sqrt{t}}, \quad \tau = h(t) = \lambda\sqrt{t} \quad (5.1)$$

$\eta, \tau$  を使つると (4.8) ~ (4.13) は次の様に變形できる。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2\eta \frac{\partial u}{\partial \eta} = -2\tau \frac{\partial u}{\partial \tau} + 4 \frac{d\tau}{dt} \tau \frac{\partial u}{\partial \tau} + 4 \frac{u_w}{u_w - u_0} \tau u \quad (5.2)$$

$$u(0, \tau) = 1, \quad u(\infty, \tau) = 0 \quad (5.3)$$

$$g_1(t) = 2\sqrt{t} \lambda \left( \frac{1}{u_w} - 1 \right) = P(\tau) = \frac{\partial u}{\partial \eta}(0, \tau) \quad (5.4)$$

$$g_2(t) = 2\sqrt{t} \left( 1 - \frac{u_0}{u_w} \right) = P(\tau) = \frac{\partial u}{\partial \eta}(0, \tau) \quad (5.5)$$

$$\lambda(0) = 0 \quad (5.6)$$

(5.1) 式の變形にまず注意しなくては、複雑な界面条件 (4.11) と (4.12) から (5.4) と (5.5) 式で分子様々二つの従属変数  $g_1(t), g_2(t)$  の、§3 で述べた  $\tau$  に関する合成関数として求めらねばならないことである。ただ当然のことながら (5.1) 式の  $\eta, \tau$  だけ



程式 (5.2) ~ (5.6) が解けることと示すには, (5.2) 式の右辺の下線と施した二項加てで表現出来るだけなければならない。これは §3 の定理 1 を使えば容易に示せる。次の仮定を行う。

仮定 1.

$u_w$  と  $\lambda$  は  $t^{\frac{1}{2}}$  について  $t=0$  で正則である。

仮定 1 により,

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_1 t^{\frac{1}{2}} + \lambda_2 t + \dots, \quad (5.7)$$

$$u_w = u_1 t^{\frac{1}{2}} + u_2 t + \dots, \quad (5.8)$$

$$\zeta = h(t) = \lambda_0 t^{\frac{1}{2}} + \lambda_1 t + \lambda_2 t^{\frac{3}{2}} + \dots \quad (5.9)$$

後の解析で分る様に  $\lambda_0 \neq 0$ ,  $u_1 \neq 0$  であり,  $h(0) = 0$  である。  $h(t)$  が正則であるから, (5.9) の逆関数も定義出来る。

$$t^{\frac{1}{2}} = h^{-1}(\zeta) = \frac{\zeta}{\lambda_0} - \frac{\lambda_1}{\lambda_0^3} \zeta^2 + \frac{2\lambda_1^2 - \lambda_0 \lambda_2}{\lambda_0^5} \zeta^3 + \dots \quad (5.10)$$

(5.7) ~ (5.10) と定理 1 を使うと

$$4 \frac{d\zeta}{dt} t = 2\zeta + B_2 \zeta^2 + B_3 \zeta^3 + \dots, \quad (5.11)$$

$$4 \frac{u_w}{u_w} t = 2 + C_1 \zeta + C_2 \zeta^2 + \dots \quad (5.12)$$

$$\therefore \zeta^2 \quad B_2 = \frac{2\lambda_1}{\lambda_0}, \quad B_3 = \frac{4(\lambda_0 \lambda_2 - \lambda_1^2)}{\lambda_0^2}, \dots \quad (5.13)$$

$$C_1 = \frac{2u_2}{u_1 \lambda_0}, \quad C_2 = \frac{2}{\lambda_0^2} \left( \frac{2u_3}{u_1} - \frac{u_2^2}{u_1^2} \right) - \frac{2u_2 \lambda_1}{u_1 \lambda_0^2}, \dots \quad (5.14)$$

(5.11), (5.12) とともに, 定理 1 により  $\zeta$  が充分小ならば収束する。(5.11), (5.12) を (5.2) に代入すれば, 濃度関数  $u(\eta, \zeta)$  は  $\eta$  と  $\zeta$  のみの関数である。一方 (5.4), (5.5) 式から  $\frac{\partial u}{\partial \eta}(0, \zeta)$  は  $\zeta$  について正則であるから,  $u(\eta, \zeta)$  も  $\zeta$  について

正則と考之こす。

$$u(\eta, \tau) = u_0(\eta) + \tau u_1(\eta) + \tau^2 u_2(\eta) + \dots \quad (5.15)$$

(5.15) を (5.2), (5.3) 式に代入する。関数列  $\{u_n(\eta)\}$  は界面条件 (5.4), (5.5) とは独立に求めることが出来る。

### § 6. 濃度関数列 $\{u_n\}$

(5.15) 式の  $\{u_n\}$  は次の式を満足し居なければならない。

$$u_0'' + 2\eta u_0' - 2u_0 = 0,$$

$$u_1'' + 2\eta u_1' - 4u_1 = -2u_0' + C_1 u_0,$$

$$u_2'' + 2\eta u_2' - 6u_2 = -2u_1' + B_2 u_1 + C_2 u_0 + C_1 u_1,$$

$$u_3'' + 2\eta u_3' - 8u_3 = -2u_2' + B_3 u_1 + 2B_2 u_2 + C_3 u_0 + C_2 u_1 + C_1 u_2,$$

⋮

(6.1)

$$u_0(0) = 1, \quad u_j(0) = 0, \quad j \geq 1, \quad (6.2)$$

$$u_j(\infty) = 0, \quad j \geq 0. \quad (6.3)$$

境界条件 (6.2), (6.3) を満足する  $\{u_n\}$  は次の様になる。

$$u_0 = D_0 \operatorname{erfc} \eta,$$

$$u_1 = D_1 i^2 \operatorname{erfc} \eta - \frac{D_0}{2} \operatorname{erfc} \eta - \frac{C_1 D_0}{2} i \operatorname{erfc} \eta,$$

$$u_2 = D_2 i^3 \operatorname{erfc} \eta - \frac{D_1 (B_1 + C_1)}{2} i^2 \operatorname{erfc} \eta + \left( -\frac{D_1}{2} + \frac{C_1 D_0 (B_2 + C_1)}{6} - \frac{C_2 D_0}{4} \right) i \operatorname{erfc} \eta \\ + \left( \frac{C_1 D_0}{6} + \frac{D_0 (B_2 + C_1)}{12} \right) \operatorname{erfc} \eta + \frac{D_0}{2\sqrt{\pi}} \exp(-\eta^2) \quad (6.4)$$

こゝで

$$D_0 = \sqrt{\pi}, \quad D_1 = 2\sqrt{\pi} \left( 1 + \frac{C_1}{\sqrt{\pi}} \right),$$

$$D_2 = \frac{(B_2 + C_1)}{4} \{3\sqrt{\pi} D_1 - (3C_1 + 2\sqrt{\pi}) D_0\} + 3D_1 + D_0 \left\{ \frac{3}{2} C_2 - \sqrt{\pi} C_1 - \frac{3}{2} \right\}. \quad (6.5)$$

$$i^n \operatorname{erfc} \eta = \int_{\eta}^{\infty} i^{n-1} \operatorname{erfc} \xi \, d\xi,$$

$$i^0 \operatorname{erfc} \eta = \operatorname{erfc} \eta = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\eta}^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi. \quad (6.6)$$

未定係数  $B_2, B_3, \dots, C_1, C_2, \dots$  は (5.13), (5.14) に与えられたおりの究極的には (5.7), (5.8) 式で示される  $\chi$  と  $u_0$  の展開係数  $\chi_0, \chi_1, \dots$  と  $u_1, u_2, \dots$  で表わされる。次にこの係数と L-B 展開を求めるところを示す。

### §7. 界面条件の L-B 展開と未定係数の決定

§6 で求めた  $\{u_n\}$  関数の  $\eta=0$  での一次微分を評価すれば、界面条件を表わす (5.4), (5.5) 式の L-B 展開式を決定出来る。

$$g_1(t) = 2\sqrt{t} \chi \left( \frac{1}{u_w} - 1 \right) = P(\tau) = u_0'(0) + \tau u_1'(0) + \tau^2 u_2'(0) + \dots \quad (7.1)$$

$$g_2(t) = 2\sqrt{t} \left( 1 - \frac{u_e}{u_w} \right) = P(\tau) = u_0'(0) + \tau u_1'(0) + \tau^2 u_2'(0) + \dots \quad (7.2)$$

こゝで、

$$u_0'(0) = -\sqrt{\pi}, \quad u_1'(0) = \frac{2C_1}{\sqrt{\pi}} \left( -1 + \frac{\pi}{4} \right), \quad u_2'(0) = (B_2 + C_1)$$

$$\left\{ \frac{10-3\pi}{12} + \frac{C_1}{\sqrt{\pi}} \left( 1 - \frac{5\pi}{16} \right) \right\} - \frac{1}{8}\sqrt{\pi} + C_1 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{5}{6} \right) - \frac{\sqrt{\pi}}{8} C_2 \quad (7.3)$$

またこの段階では、L-B 展開には  $C_1, C_2$  etc の未定係数が含まれてゐる。これを決定するには式 (5.7) ~ (5.9) の展開を (7.1) と (7.2) 式の両辺に代入し  $t^{1/2}$  についての同じべきの係数を等しいとおく。例えば、 $(t^{1/2})^0$  の項からは

$$\frac{2\chi_0}{u_1} = -\sqrt{\pi}, \quad -\frac{2u_e}{u_1} = -\sqrt{\pi}$$

$$\therefore x_0 = -u_e, \quad u_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} u_e \quad (7.4)$$

同様に手廻り  $x_1, x_2, \dots, u_2, u_3, \dots$  と順次求めることが出来る。

$$x_0 = -u_e, \quad x_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} u_e (1 - u_e), \quad x_2 = u_e (1 - u_e) \frac{(8 + \pi)u_e - 2\pi}{2\pi}, \dots \quad (7.5)$$

$$u_1 = \frac{2u_e}{\sqrt{\pi}}, \quad u_2 = -\frac{u_e(2-u_e)}{2}, \quad u_3 = \frac{1}{\pi\sqrt{\pi}} \left[ \frac{u_e^3}{36} (-3\pi^2 + 44\pi - 64) \right. \\ \left. - \frac{u_e}{9} (3\pi^2 + 14\pi - 16) + \frac{4}{3} u_e (\pi - 2) \right], \dots \quad (7.6)$$

以上の結果を用くと、L-B展開は

$$g_1(t) = 2\sqrt{t} \bar{x} \left\{ \frac{u_e}{u_w} - u_e \right\} = P(\bar{c}) = d_0 + d_1 \bar{c} + d_2 \bar{c}^2 + \dots \quad (7.7)$$

$$g_2(t) = 2\sqrt{t} \left\{ 1 - \frac{u_e}{u_w} \right\} = P(\bar{c}) = d_0 + d_1 \bar{c} + d_2 \bar{c}^2 + \dots \quad (7.8)$$

$$\therefore \bar{c} \quad d_0 = -\sqrt{\pi}, \quad d_1 = \frac{8 - (2 - u_e)\pi}{4},$$

$$d_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[ \frac{u_e^2}{144} (-3\pi^2 + 10\pi - 128) + \frac{u_e}{36} (3\pi^2 + 26\pi - 112) - \frac{1}{12} (3\pi^2 - 2\pi - 32) \right],$$

$\bar{x}$  と  $\bar{c}$  は次の様に再定義してある。

$$\bar{x} = -X/u_e, \quad \bar{c} = \bar{x} \sqrt{t} \quad (7.9)$$

(7.9) 式の再定義の利点は、 $u_e$  の符号に関わらず  $\bar{x}$  は常に正とともに増加することである。

計算が非常に複雑になるので本論文では L-B 級数の 3 項しか求めない。ゆえに、L-B 級数 (7.7), (7.8) の収束を直接確認することは不可能である。仮定 1 (8.5 と 8.6) により  $g_1(t), g_2(t)$ ,  $h(t)$  の正則性を示すので上の L-B 級数は  $\bar{c}$  が充分小さければ収束する。

8.8. 界面位置  $X(t)$  と界面濃度  $u_w(t)$  の求め方

仮定 1 により, L-B 級数 (7.7), (7.8) は解析関数  $P(z)$  と定義する。両式の左辺から  $u_w$  を消去すると

$$\sqrt{t} = \frac{z P(z)}{P(z) + 2z(1-u_e)} = Q(z). \quad (8.1)$$

$P(0) = -\sqrt{\pi} \neq 0$  に注意すれば, (8.1) の右辺は  $z=0$  で正則であり,  $Q(0) = 0$  である様な擬単数 (almost unit) の解析関数  $Q(z)$  と定義することができる。よって (8.1) 式の逆関数を求めることが出来ると

$$z = Q^{-1}(\sqrt{t}). \quad (8.2)$$

(8.2) 式は, (6.1) の  $h(t)$  の定義から明らかであるように,  $X(t)$  についての一階の常微分方程式となり, 定理 2 により, これは目的関数  $X(t)$  と一致する。そこで (7.7) 又は (7.8) 式を  $e^n$  で打ち, 長  $P_n(z)$  を (8.1) の  $P(z)$  の所に代入して (8.2) 式を解いて求める  $\{X^{(n)}\}$ , さらに  $\{u_w^{(n)}\}$  は定理 3 により  $X(t), u_w(t)$  に収束せしめられる。以下  $n=0, 1, 2, \dots$  とこの手順に従って  $\{X^{(n)}\}, \{u_w^{(n)}\}$  を求める。

$n=0$  :

$P_0(z) = -\sqrt{\pi}$  とおくと, (8.2) 式は

$$\frac{dX^{(0)}}{dt} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{t} + (1-2u_e)2\sqrt{t}} \quad (8.3)$$

初期条件 (5.6) を満たす解の容易に求め, 2,

$$X^{(0)} = \frac{\sqrt{\pi}}{1-u_e} \sqrt{t} - \frac{\pi}{2(1-u_e)^2} \log \left\{ 1 + \frac{2(1-u_e)}{\sqrt{\pi}} \sqrt{t} \right\}, \quad (8.4)$$

$$u_w^{(0)} = \frac{2u_e \sqrt{t}}{2\sqrt{t} + \sqrt{\pi}}. \quad (8.5)$$

$t \ll 1$  の時は,  $\bar{\chi}^{(0)}$ ,  $u_w^{(0)}$  は次の展開である。

$$\begin{aligned}\bar{\chi}^{(0)} &\sim t - \frac{4(1-u_e)}{3\sqrt{\pi}} t^{\frac{3}{2}} + \dots \\ u_w^{(0)} &\sim \frac{2}{\sqrt{\pi}} u_e \sqrt{t} - \frac{4}{\pi} u_e t + \dots\end{aligned}\quad (8.6)$$

$t \gg 1$  の時は,

$$\begin{aligned}\bar{\chi}^{(0)} &\sim \frac{\sqrt{\pi}}{1-u_e} t^{\frac{1}{2}} - \frac{\pi}{4(1-u_e)^2} \log t + \dots \\ u_w^{(0)} &\sim u_e - \frac{u_e \sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} + \dots\end{aligned}\quad (8.7)$$

$n=1$  :

$$\frac{d\bar{\chi}^{(1)}}{dt} = \frac{D}{2d_1} + \frac{\sqrt{\pi}}{2d_1\sqrt{t}} - \frac{1}{2d_1\sqrt{t}} \left[ (D\sqrt{t} + \sqrt{\pi})^2 - 4d_1\sqrt{\pi t} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (8.8)$$

$$t \ll 1, \quad D = \frac{(8-\pi)(2-u_e)}{4}, \quad d_1 = 2 - \frac{\pi}{4}(2-u_e).$$

$$\begin{aligned}\bar{\chi}^{(1)} &= \frac{D}{2d_1} t + \frac{\sqrt{\pi t}}{d_1} - \frac{1}{2d_1} \left[ (t + \frac{\sqrt{\pi} D'}{D}) \sqrt{(D\sqrt{t} + \sqrt{\pi})^2 - 4d_1\sqrt{\pi t}} - \frac{\pi^{\frac{3}{2}} D'}{D^2} \right] \\ &\quad - \frac{8\pi(1-u_e)}{D^3} \log \left\{ \frac{D \sqrt{(D\sqrt{t} + \sqrt{\pi})^2 - 4d_1\sqrt{\pi t}} + D^2\sqrt{t} + \sqrt{\pi} D'}{4\sqrt{\pi}(1-u_e)} \right\},\end{aligned}\quad (8.9)$$

$$u_w^{(1)} = \frac{2u_e\sqrt{t}}{2\sqrt{t} + \sqrt{\pi} - d_1\bar{\chi}^{(1)}\sqrt{t}} \quad (8.10)$$

$$t \gg 1 \quad D' = \frac{\pi}{4}(2-u_e) - 2u_e.$$

$t \ll 1$  の時は,  $\bar{\chi}^{(1)}$ ,  $u_w^{(1)}$  は次の展開である。

$$\begin{aligned}\bar{\chi}^{(1)} &\sim t - \frac{2(1-u_e)}{\sqrt{\pi}} t^{\frac{3}{2}} + \dots \\ u_w^{(1)} &\sim \frac{2u_e}{\sqrt{\pi}} \sqrt{t} - 2u_e(1+u_e)t + \dots\end{aligned}\quad (8.11)$$

$t \gg 1$  の時は,

$$\begin{aligned}\bar{\chi}^{(1)} &\sim \frac{\sqrt{\pi}}{1-u_e + \frac{d_1}{2}} \sqrt{t} - \frac{4\pi(1-u_e)}{D^3} \log t + \dots \\ u_w^{(1)} &\sim u_e - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{D'}{D} \frac{u_e}{\sqrt{t}} + \dots\end{aligned}\quad (8.12)$$

当然のことだが,  $\bar{\chi}^{(1)}$ ,  $u_w^{(1)}$  の  $t \ll 1$  の最初の 2 項は (7.4); (7.5)

と与えられる係数と一致している。

$n \geq 2$  については,  $\chi^{(n)}, u_w^{(n)}$  の解析解を求めると困難が  
ある。(8.1)式は与えられた  $(n+1)$  次の代数方程式に  
なり, これを Newton 法により解 (8.2) を求め, その微分方程式  
を Runge-Kutta 法で数値的に解くという方法をとる。これ  
により求めた数値解を Table 1 において  $u_e$  について示  
してある。

### §9. 考察

考慮した L-B 級数の次数内では, §8 の結果は (7.5), (7.6)  
式に示されている古典解と一致するのを見事に確認出来る。  
例えば (8.6), (8.11) 式を見よ。古典解の最初の二項は Ghez<sup>5)</sup>  
による。本 L-B 解の優れている点は, 時間の小さな領域では  
古典的級数解ともそろって一致するだけでなく,  $t \gg 1$  の領域  
でも正しい漸近的挙動を示す点である。  $t \rightarrow \infty$  の極限では,  
結晶成長の律速過程は拡散律速となり, 界面条件は熱力学  
的平衡状態を満足し,  $u_w \rightarrow u_e$  となる。この場合には, 熱の  
Neumann の解に当たる厳密解がある。これは実質的には Ghez<sup>5)</sup>  
により解は与えられている。

$$\bar{\chi} = 2\lambda \cdot \sqrt{t}$$

$$u_w = u_e$$

(9.1)

$$\lambda_0 \operatorname{erfc} \lambda_0 \exp(\lambda_0^2) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{1 + u_0} \quad (9.2)$$

$u_0$  が小さいときは  $\lambda_0$  は次の解をもつ。

$$\lambda_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[ 1 + \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) u_0 - \left(1 - \frac{5}{\pi} + \frac{8}{\pi^2}\right) u_0^2 + \dots \right] \quad (9.3)$$

(8.7), (8.12) 式の  $t \gg 1$  の展開を  $\eta$  としても分る様に  $\bar{x}^{(0)}$ ,  $\bar{x}^{(1)}$ ,  $u_w^{(0)}$ ,  $u_w^{(1)}$  と定数  $\lambda_0$  の値は  $\eta$  が  $1$  より正しくなるが ( $u_0 = 0$  として (9.3) を使えば  $\eta = 0$ ,  $1$  であり  $\eta$  は約 60%, 30% 大きい) 正しい関数形を  $\eta$  を用いて表すことに注意される。Table 1 の数値から分る様に、充分時間の大い領域でも、 $\bar{x}^{(0)}$ ,  $\bar{x}^{(1)}$ ,  $\bar{x}^{(2)}$  と  $n=0, 1, 2$  とよく収束している状態から分かる。

本研究は文部省科学研究費による補助による。

## 文献

- 1). R.W. Dutton & D.A. Antoniadou: p. 233 in *Moving Boundary Problems* ed. by D.G. Wilson, A.P. Solomon & P.T. Boggs. Academic Press, New York. (1978)
- 2). R. Ghez & E.A. Giess: *Mat. Res. Bull.* 8, p. 31 (1973)
- 3). H.B. Smelt & R. Ghez: *J. Appl. Phys.* 50, p. 5322 (1979)
- 4). 大川幸哉: *結晶成長*, 裳華房. (1980)
- 5). R. Ghez: *Int. J. Heat Mass Transfer*, 23, p. 425 (1980).
- 6). R. Ghez: *J. Crystal Growth*, 43, p. 618 (1978).
- 7). N. Tokuda "A new application of Lagrange-Bürmann expansions" I & II submitted to *ZAMP*.



TABLE 1. Lagrange-Burmann Solutions of Crystal Growth

$u_e = 0.05$		$u_e = 0.5$					
n	X	time	h(t)	$u_w$	time	h(t)	$u_w$
0	0.2	.272	.334	.019	.236	.381	.177
1		.278	.326	.020	.242	.368	.200
2		.279	.323	.020	.244	.363	.209
0	0.4	.613	.426	.024	.504	.507	.222
1		.636	.407	.025	.528	.476	.256
2		.644	.401	.026	.540	.460	.272
0	1.0	1.918	.557	.031	1.43	.714	.287
1		2.068	.516	.033	1.59	.629	.334
2		2.127	.500	.033	1.69	.577	.358
0	2.0	4.853	.655	.036	3.29	.896	.336
1		5.455	.589	.038	3.95	.736	.386
2		5.731	.561	.039	4.48	.642	.411
0	3.0	8.612	.708	.038	5.46	1.01	.363
1		9.969	.625	.041	6.98	.789	.410
2		10.638	.589	.041	8.29	.669	.434
0	5.0	18.371	.766	.041	10.63	1.15	.392
1		22.156	.662	.043	14.92	.84	.439
2		24.158	.617	.044	18.86	.69	.456

X; Thickness of crystal formed

time; Time taken to reach thickness X(t)

$u_w$ ; surface concentration

h(t); see equatin (5.1)

$u_e$ ; Dimensionless parameter of equilibrium concentration. see equation (4.7)

n; order of approximations